Yb:GdCOB 晶体被动调 Q 脉冲激光器实验研究

代启彪1 易红英1 田雪苹1 韩文娟1,2 刘均海1,2

(¹青岛大学物理科学学院,山东青岛 266071 ²山东省高校光子学材料与技术重点实验室(青岛大学),山东青岛 266071

摘要 以 Cr⁴⁺:YAG 晶体作为可饱和吸收体,利用平-凹谐振腔实现了 Yb:GdCOB 晶体的被动调 Q 激光运转。当 沿 X 轴切割的厚度为 2.0 mm 的晶体吸收抽运功率为 6.3 W 时,所产生的沿 Z 主轴方向偏振的平均脉冲输出功率 达到 0.62 W,脉冲重复率为 3.6 kHz,相应的单脉冲能量、脉冲宽度和峰值功率分别为 172 μJ、20 ns 和 8.6 kW。 关键词 激光器; Yb³⁺激光器; 被动调 Q; Yb:GdCOB 晶体 中图分类号 TN248.1 文献标识码 A doi: 10.3788/CJL201340.0802002

> Experimental Study on Passively Q-Switched Laser with Yb:GdCOB Crystal

Dai Qibiao¹ Yi Hongying¹ Tian Xueping¹ Han Wenjuan^{1,2} Liu Junhai^{1,2}

¹ College of Physics, Qingdao University, Qingdao, Shandong 266071, China

² Key Laboratory of Photonics Materials and Technology in Universities of Shandong, Qingdao University, Qingdao, Shandong 266071, China

Abstract Passively *Q*-switched laser operation with Yb : GdCOB crystal is demonstrated in a plano-concave resonator, utilizing a Cr^{i+} : YAG saturable absorber. When the absorbed pump power of the 2-mm thick *X*-cut crystal is 6.3 W, an average pulsed output power of 0.62 W, with polarization parallel to the *Z* principal axis, is generated at a pulse repetition frequency of 3.6 kHz. The resulting pulse energy, duration, and peak power are 172 μ J, 20 ns, and 8.6 kW, respectively.

Key words lasers; Yb³⁺ laser; passive Q-switching; Yb:GdCOB crystal OCIS codes 140.3615; 140.3540; 140.3480

1 引 言

随着发射波长为 970~980 nm 的光纤耦合高 亮度 InGaAs 半导体激光器的发展,以此为抽运源 的 Yb³⁺固体激光器的研究得到广泛关注。与传统 的振荡波长为 1.06 μm 的 Nd³⁺激光器相比,Yb³⁺ 激光器的突出优点包括:激光发射过程所产生的量 子缺损显著降低;不存在浓度猝灭和上转换等不利 作用过程;激光介质具有宽得多的发射谱,有利于通 过锁模技术产生超短脉冲^[1-2]。此外,相对于 Nd 激光材料而言,Yb 激光介质一般具有小的受激发 射截面和长的荧光寿命,从而具有大的储能本领,这 对于发展高能量脉冲激光器具有重要意义。

在目前已知的有重要应用前景的 Yb 激光晶体 中,Yb:GdCa₄O(BO₃)₃(Yb:GdCOB)和 Yb:YCa₄O (BO₃)₃(Yb:YCOB)两种晶体的受激发射截面与其 他晶体相比小得多,而其荧光寿命则长得多^[3-4]。 GdCOB 和 YCOB 是一类对称性很低的稀土钙氧硼 酸盐(点群为 m),为单斜晶系的双轴晶体。这类晶 体是上世纪九十年代中期首次被合成,最初被用作 非线性光学晶体,但不久即被证明也可作为 Yb³⁺的 基质晶体^[3-4]。随后,研究人员对 Yb:GdCOB 晶体 的光谱性质和激光特性开展了很多实验研究。相关

收稿日期: 2013-01-17; 收到修改稿日期: 2013-03-18

基金项目:国家自然科学基金(60978023)

作者简介:代启彪(1989—),男,硕士研究生,主要从事 Yb³⁺激光器方面的研究。E-mail: qibiao. dai@yahoo. com. cn **导师简介**:刘均海(1964—),男,理学博士,教授,主要从事新型激光晶体和全固态激光器等方面的研究。

E-mail: junhai_liu@hotmail.com(通信联系人)

工作包括:实现了可调谐激光运转,其波长调谐范围 超过 100 nm^[5];实现了被动锁模激光运转,所产生 的激光脉冲宽度为 90 fs^[6];获得了功率为 5~7 W 的连续波激光输出,并发现该晶体所产生的连续波 激光振荡会呈现复杂的偏振态变化行为^[7-9]。然 而,尽管 Yb:GdCOB 晶体的储能本领高于大多数 Yb³⁺晶体,其在脉冲激光器方面的应用潜力还很少 受到关注。实际上,该晶体的基本脉冲激光特性尚 未见报道。

本文报道了 Yb:GdCOB 晶体被动调 Q 脉冲激 光特性的初步实验结果。利用 Cr⁴⁺:YAG 晶体作为 可饱和吸收体,以光纤耦合半导体激光器为抽运源, 实现了 Yb:GdCOB 晶体的被动调 Q 脉冲激光运 转,获得了稳定的高能量激光脉冲。

2 实验装置

实验中 Yb: GdCOB 晶体被动调 Q 激光器由平-凹谐振腔构成,如图1所示。其中平面镜 M1 靠近晶 体的一面镀有对 1020~1200 nm 波段高反,同时对 808~980 nm 波长范围高透的介质膜;而另一面镀有 对 800~1000 nm 波段的增透膜。输出耦合镜 M2 为 曲率半径为 50 mm 的凹面镜,在 1030 nm 的透射率 T=20%。实验中使用的激光晶体(LC)Yb:GdCOB 的 Yb³⁺ 掺杂浓度(原子数分数)为 15%。晶体样品沿 X轴切割,厚度为2.0 mm,横截面为3.3mm× 3.3 mm,样品两个端面未镀增透膜。为减轻晶体内 热效应对激光振荡的影响,晶体样品置入水冷铜块 内,冷却水温度控制在5℃。用于产生被动调Q的可 饱和吸收体(SA)为 Cr4+;YAG 晶体,其初始透射率 $T_0 = 97.5\%$,晶体的两个端面镀 1.03 µm 的增透膜。 实验中所使用的抽运源为高亮度光纤耦合半导体激 光器,光纤纤芯直径为200 μm,数值孔径为 0.22,其 中心发射波长随输出功率水平不同在 968~971 nm



图 1 Yb:GdCOB 被动调 Q 脉冲激光器实验装置示意图 Fig. 1 Schematic diagram for the passively Q-switched Yb:GdCOB laser 范围内变化。抽运光经一个聚焦系统耦合到 Yb: GdCOB 晶体内,光斑半径约为 100 μm。激光器谐振 腔的长度为28 mm。利用一个分束器,可同时由功率 计(OPHIR NOVA II型)测量 Yb:GdCOB 激光器产生 的输出功率,由示波器(Infinitum DSO80304B型, Agilent Co. Ltd., 3 GHz, 40 G Sa/s)测量激光脉冲 参数,或由光谱仪(Avantes AvaSpec-3648型)测量激 光发射谱。

3 实验结果和讨论

利用图 1 所示的实验装置,实现了 Yb:GdCOB 晶体的被动调 Q 激光运转。图 2 给出了实验测量 的平均脉冲输出功率随晶体吸收抽运功率的变化关 系。作为比较,图中还给出了相同谐振腔条件下得 到的连续波激光振荡输出特性。无论是连续波还是 脉冲运转,所产生的激光输出均为沿 Z 轴方向的线 偏振光,这与文献[9]报道的连续波激光振荡偏振方 向一致。



描运功率的变化 Fig. 2 Output power versus the absorbed

pump power of Yb:GdCOB laser

由图2看出,Yb:GdCOB 晶体调 Q运转的阈值 抽运功率为4.05 W。随着抽运功率的升高,所产生 的平均输出功率近似呈线性增加。在抽运功率为 6.3 W时,脉冲激光平均功率为 0.62 W,相应的光-光转换效率为 10%,斜率效率为 28%。在相同的谐 振腔条件下,连续波激光运转的阈值抽运功率为 3.6 W。当晶体所吸收的抽运功率为 6.3 W时,连 续波激光输出功率为 0.80 W,相应的斜率效率为 30%。调 Q运转的平均输出功率与连续波输出功 率之比为 0.78,显示出较高的调 Q效率。与连续波 激光运转相比,调 Q运转的斜率效率略有降低,这 是由腔内可饱和吸收体的附加损耗所引起的。

实验中 Yb:GdCOB 晶体的被动调 Q 激光运转

所使用的输出镜具有较高的透射率(T=20%),这 是为了避免对腔内元件产生光损伤。在调Q运转 条件下,低的输出耦合透射率将导致腔内形成过高 的峰值功率密度,容易使光学元件表面出现损伤。 另外,较高的输出镜透射率也有利于产生较短的激 光脉冲。当然,降低可饱和吸收体的初始透射率 T_0 ,可以有效地提高单脉冲能量和减小脉冲宽度。 除了 $T_0=97.5\%$ 的 Cr⁴⁺:YAG 晶体之外,实验中 也尝试使用了 $T_0=95\%$ 的可饱和吸收体,但未能实 现稳定的调Q脉冲激光振荡。

图 3 为抽运功率为 5.6 W 时测量得到的调 Q 以及连续波运转的激光发射谱。从图中看出,连续 波激光发射谱很宽,在 1030.0~1039.2 nm 范围内

均有激光振荡产生。实际上,具有宽的发射谱也是 Yb³⁺激光器连续波运转的一般特征,这一点与传统 的Nd³⁺激光器有很大的差异。在图 3(b)所示的连 续波发射谱中,存在约 10 条分立的谱线,相邻谱线 的间隔约为 1 nm。应当指出,这些发射谱线与谐振 腔纵模之间并不存在一一对应的关系。这些分立的 谱线实际上起因于未镀膜的 Yb:GdCOB 晶体表面 与谐振腔的平面镜 M1之间所形成的空气隙标准具 作用,谱线间隔相对应于该标准具(厚度约为 0.5~ 0.6 mm)的自由光谱范围。由图 3(b)可以看出,在 被动调 Q运转条件下,激光发射谱变得很窄,仅包 含一条 1035 nm 的主要谱线,这是被动调 Q过程中 所伴随的纵模选择作用结果¹¹⁰。



图 3 抽运功率为 5.6 W 时测量得到的激光发射谱。(a) 调 Q 运转;(b) 连续波运转 Fig. 3 Laser emission spectra measured when absorbed pump power is 5.6 W. (a) Q-switched operation; (b) continuous-wave operation

对于被动调 Q 激光运转,激光脉冲重复频率一 般随抽运功率增加而升高。图 4 所示在输出耦合镜 透射率为 20%,可饱和吸收体初始透射率为 97.5% 的条件下,Yb:GdCOB 晶体激光器的脉冲重复频率 随晶体吸收抽运功率的变化情况。在振荡阈值附近, 脉冲重复频率很低,约为 0.25 kHz;随抽运功率升 高,脉冲重复频率近似线性增加;在晶体最高吸收抽 运功率为 6.3 W 时,脉冲重复频率达到 3.6 kHz。



图 4 脉冲重复频率随晶体吸收抽运功率的变化 Fig. 4 Repetition frequency versus the absorbed pump power

一 由图 2 给出的最大脉冲输出功率测量值(0.62 W),

可得到此时的单脉冲能量为172 "J。

与激光脉冲重复频率随抽运功率的变化不同。 实验表明,Yb:GdCOB晶体激光器被动调Q所产生 的激光脉冲轮廓和脉冲宽度随抽运功率的升高仅有 微小的变化。图5为晶体吸收抽运功率为5.3W时 测量得到的单脉冲轮廓和稳定的脉冲串。在略高于 阈值时,脉冲宽度为22.5 ns;随着抽运功率的增加,



图 5 被动调 Q产生的脉冲轮廓和脉冲串 Fig. 5 Pulse profile and pulse train of passively Q-switched operation

脉冲宽度为 20 ns,基本保持不变。激光脉冲的上升 沿和下降沿基本上是对称的,表明实验所选定的被 动调 Q 条件(包括输出耦合透射率和可饱和吸收体 的初始透射率等)是适宜的^[11]。

由平均输出功率和脉冲重复频率可以得到单脉冲能量。随吸收抽运功率的增加,单脉冲能量基本保持不变(涨落不超过 10%),平均能量为 160 μ J。 图 5 所示稳定的脉冲串和图 6 单脉冲能量的微小变 化表明,Yb:GdCOB 在该实验条件下得到了稳定的 脉冲振荡。由平均单脉冲能量(160 μ J)和脉冲宽度 (20 ns),可得到平均脉冲峰值功率为 8.0 kW。利 用以 色 列 Duma Optronics Ltd. 公司生产的 BeamOn IR1550型光束分析仪测得,输出激光的光 束质量因子分别为 $M_x^2 = 2.3$ 和 $M_y^2 = 2.17$,远场光 斑轮廓如图 7 所示。



图 6 单脉冲能量随吸收抽运功率的变化

Fig. 6 Pulse energy versus absorbed pump power



图 7 远场光斑轮廓图 Fig. 7 Laser profile in far field

4 结 论

实现了以 Cr⁴⁺:YAG 晶体作为可饱和吸收体 的 Yb:GdCOB 晶体被动调 Q 激光运转。在谐振腔 输出耦合透射率为 20%、可饱和吸收体初始透射率 为 97.5%的条件下,获得了重复频率为 3.6 kHz、最 大平均功率为 0.62 W 的 1035 nm 脉冲激光振荡, 相应的单脉冲能量、脉冲宽度和峰值功率分别为 172 μ J、20 ns 和 8.6 kW。

参考文献

1 Zhang Haikun, Cui Xuelong, Xu Jinlong, et al.. CW modelocked Yb:NaY (WO₄)₂ femtosecond laser with a semiconductor saturable-absorber mirror[J]. Chinese J Lasers, 2012, 39(11): 1102002.

张海鹍,崔雪龙,徐金龙,等. 基于半导体可饱和吸收镜锁模的 Yb:NaY(WO₄)₂ 飞秒激光器[J]. 中国激光, 2012, 39(11): 1102002.

2 Zhang Yongdong, Wei Zhiyi, Zhang Zhiguo, *et al.*. Laser diode pumped efficient continuous wave and picoseconds Yb: YGG laser [J]. Chinese J Lasers, 2011, 38(2): 0202005.

张永东,魏志义,张治国,等.激光二极管抽运的高功率 Yb: YGG 激光器的连续及锁模运转[J].中国激光,2011,38(2): 0202005.

- 3 A Brenier. A new evaluation of Yb³⁺-doped crystals for laser applications[J]. J Lumin, 2001, 92(3): 199-204.
- 4 G Boulon. Yb³⁺-doped oxide crystals for diode-pumped solid state lasers: crystal growth, optical spectroscopy, new criteria of evaluation and combinatorial approach[J]. Opt Mater, 2003, 22 (2): 85-87.
- 5 F Mougel, K Dardenne, G Aka, *et al.*. Ytterbium-doped Ca₄GdO (BO₃)₃: an efficient infrared laser and self-frequency doubling crystal[J]. J Opt Soc Am B, 1999, 16(1): 164-172.
- 6 F Druon, F Augé, F Balembois, *et al.*. Efficient, tunable, zeroline diode-pumped, continuous-wave Yb³⁺ : Ca₄LnO (BO₃)₃ (Ln=Gd, Y) lasers at room temperature and application to miniature lasers[J]. J Opt Soc Am B, 2000, 17(1): 18-22.
- 7 F Augé, F Balembois, P Georges, *et al.*. Efficient and tunable continuous-wave diode-pumped Yb: Ca₄GdO (BO₃)₃ laser[J]. Appl Opt, 1999, 38(6): 976-979.
- 8 F Druon, F Balembois, P Georges, et al.. Generation of 90-fs pulse from a mode-locked diode-pumped Yb³⁺: Ca₄GdO (BO₃)₃ laser[J]. Opt Lett, 2000, 25(6): 423-425.
- 9 S Chénais, F Druon, F Balembois, *et al.*. Multiwatt, tunable, diode-pumped CW Yb:GdCOB laser[J]. Appl Phys B, 2001, 72 (4): 389-393.
- 10 O Svelto. Principles of Lasers [M]. Berlin: Springer, 2010. 325-327.
- 11 J J Zayhowski, P L Kelley. Optimization of Q-switched lasers
 [J]. IEEE J Quantum Electron, 1991, 27(9): 2220-2225.

栏目编辑:张 腾